[2023201001]

イオン注入による新たな超高感度同位体分析手法の開拓 Development of an Ultra-high Sensitivity Isotope Analysis by Ion Implantation

藤谷渉 #,A),橋爪光 A),山中千博 B), Wataru Fujiya ^{#,A)}, Ko Hashizume ^{A)}, Chihiro Yamanaka ^{B)} ^{A)} Faculty of Science, Ibaraki University ^{B)} Gradual School of Science, Osaka University

Abstract

Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) is a powerful tool that can determine elemental and isotopic compositions with high sensitivity in a microscopic region of several microns in a sample. In this method, a primary ion beam is irradiated onto the sample surface, and the generated secondary ions are introduced to a mass spectrometer. However, since there are many unknowns about the process of secondary ion generation, it is necessary to calibrate observed values using standard materials with known concentrations for quantitative analysis. In this work, in order to produce standard materials by implanting ions with a known dose, we conducted a basic experiment to confirm whether the implanted ions and the ions originally contained in the sample had the same sensitivity of SIMS. We implanted ${}^{13}C^+$ and ${}^{53}Cr^+$ ions into materials with known C or Cr concentrations, respectively. SIMS analyses of these samples indicate that the sensitivities of the implanted ions are very close to that of the intrinsic ions. This suggests that ion implantation is useful for preparing SIMS standard materials.

Keyword: ion implantation, secondary ion mass spectrometry, standard material

1. はじめに

1.1 二次イオン質量分析と標準試料

二次イオン質量分析 (Secondary Ion Mass Spectrometry: SIMS) は一次イオンビームを試料表面 に照射し、スパッタリングによって生成する二次イ オンに対して質量分析する手法である。電子プロー ブマイクロアナライザなど他の分析手法と比較して 高感度 (ppb オーダーの濃度の元素まで検出可能) で あること、一次イオンビームの径を絞ることで高い 空間分解能(最小で 100 nm) で分析が可能なこと、 が特徴である。そのため、例えば、材料工学や生物 学、地球科学分野において、試料の微小領域におけ る元素組成や同位体組成の測定に応用され、多くの 成果を挙げてきた。

SIMSにおいて、一次イオンによる試料のスパッタ リングと二次イオン生成の過程はあまり理解されて いない。二次イオンの生成率は物質ごとに異なり、 理論的に評価することは困難である。これはマトリ クス効果と呼ばれている。そのため、二次イオン強 度から元素濃度は推定できず、通常は濃度既知の物 質(標準試料)の分析値で未知試料の分析値を較正 する。だが、標準試料が入手困難な場合も多く、そ のときは分析値の定量性(確度)が著しく損なわれ る。例えば、隕石に含まれる炭酸塩鉱物の⁵³Mn-⁵³Cr 年代測定では、SIMSで⁵⁵Mn/⁵²Cr比を定量する必要 があるが、地球で天然に産出する炭酸塩鉱物はほと んど Cr を含まないため、Cr 濃度既知の炭酸塩標準 試料の準備は極めて困難であった。

1.2 イオン注入による SIMS 標準試料作製の試み

そこで、イオン注入により標準試料を作製し、 SIMS 分析に利用するという試みがなされている^[1]。 イオン注入では、ドーズ量を規定することで、試料 中に既知の濃度の元素を含ませることが原理的には 可能である。しかしながら、SIMS 分析における二次 イオン生成過程において、注入したイオンが試料の 結晶中に含まれているイオンと同様のふるまいをす るかは明らかではない。すなわち、SIMS 分析の感度 が両者で異なる場合は、イオン注入で作製した標準 試料を未知試料に含まれている元素の定量に用いる ことはできない。

そこで本研究計画では3年間にわたって、イオン 注入を行った試料に対して、SIMS分析の感度を確か める基礎実験を行ってきた。具体的には、CやCrの 濃度が既知の試料にあえて¹³C⁺や⁵³Cr⁺のイオンを注 入することで、注入イオンと試料由来のイオンとで SIMSの感度が異なるか確認する実験を行った。今回 は報告書では、2023年度に SIMS分析を行った結果 を含めて、これまでイオン注入を行ってきた試料の 分析結果をまとめて示す。

2. 実験・分析手順

2.1 試料の準備とイオン注入

試料はアメリカ合衆国アリゾナ州サン・カルロス 産のカンラン石[(Mg,Fe)₂SiO₄]、メキシコ産方解石 [CaCO₃]、NIST 612 glass 標準試料、SiC ウェハーな どを用いた。試料は樹脂に包埋し、粒径 0.25 μm の ダイヤモンドペーストを用いて表面の鏡面研磨を行 った。今年度に注意した点は、前年度までとは異な り、試料を同じ樹脂にマウントし、その後のイオン 注入を完全に同条件で行うようにしたことである。 イオン注入時および SIMS 分析時の帯電を防ぐため、 表面にはオスミウムによるコーティング(厚さ5 nm) を行った。試料はグリッド(5 mm 間隔)の入った銅

[2023201001]

板に導電テープで固定し、イオン注入装置の内部に 設置した。注入イオンを試料表面の汚染と区別する ため、注入するイオン源は同位体ラベルされたもの を用いるのが望ましい。今回は、¹³CO₂ + Ar 混合ガ スのボンベを施設に持ち込んで使用し、¹³C の高強度 ビーム (>100 nA)を試料に照射した。また Cr につ いてはマスフィルターを使用して⁵³Cr⁺のみを選別し、 試料に照射した。

イオン注入の実験はイオン照射研究施設(TIARA) で行った。¹³C⁺のイオンビームは 60 keV (SiC)および 130 keV (CaCO₃)に加速し、ビーム強度は 100 nA に 設定した。イオンビームは 10 × 10 mm²から 15 × 15 mm²の領域をスキャンし、ドーズ量が1×10¹⁶ ion/cm² となるよう試料に照射した。ただし、スキャン領域 はグリッドの間隔を目安に設定しているため、この ドーズ量には数10%の不確定性があると考えられる。 53Cr⁺のイオンビームは、ビーム強度 30 nA、加速電圧 300 keV に設定し、ドーズ量が 2.22 × 10¹⁴ ion/cm²と なるよう試料に照射した。注入イオンのエネルギー (加速電圧) とドーズ量は、SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter)という計算コードを用いたシ ミュレーションにより決定した^[2]。一連の実験では、 SIMS 分析を行う際に試料表面の汚染の影響を受け ないように、表面から 100-300 nm に注入イオン存在 量のピークが見られるようにエネルギーを設定した。 また、ドーズ量は、SIMS 分析の際に確実に試料由来 の元素と区別できるよう、ピーク濃度が試料中の濃 度の2倍以上になるように設定した。

2.2 SIMS 分析

イオン注入を行った試料は、東京大学マテリアル 先端リサーチインフラ・データハブ拠点 微細構造 解析部門に設置されている SIMS: NanoSIMS 50L(フ ランス・CAMECA 社製)を用いて分析を行った。

⁵³Cr⁺イオンを注入したカンラン石と NIST 612 glass に対しては、O⁻一次イオンビームを用い、ビー ム電流は 200 pA に調整した。発生する ³⁰Si⁺, ^{52,53}Cr⁺, ⁵⁵Mn⁺の各二次イオンを二次電子増倍管で同時に検 出した。このとき、⁵²Cr⁺イオンはすべて試料由来で あるため、試料中の ⁵³Cr/⁵²Cr 比を仮定することで、 ⁵³Cr⁺の信号から試料由来の ⁵³Cr の寄与を除き、注入 した ⁵³Cr 由来の信号を計算した。

 ¹³C+イオンを注入した SiC と方解石に対しては、 Cs⁺一次イオンビームを用い、ビーム電流はそれぞれ
l pA および 15 pA に調整した。発生する^{12,13}C,¹⁸O,
³⁰Si⁻の各二次イオンを二次電子増倍管で同時に検出
した。⁵³Cr⁺の実験と同様に、¹²C・イオンはすべて試料
由来である。そのため、試料中の¹³C/¹²C 比を仮定し、
¹³C⁺の信号から試料由来の¹³C の寄与を除くことで、
注入した⁵³C⁺由来の信号を計算した。

SIMS は試料を破壊しながら分析をしていく「破壊 分析」である。そのため、得られた二次イオン信号 強度を時間の関数として表示することで、注入イオ ンの深さ方向プロファイルを得ることができる。 SIMS の分析痕の深さはレーザー顕微鏡(Kevence, VK-9700) を用いて測定し、得られた深さ方向プロフ アイルは SRIM コードによるシミュレーションと比 較した。

分析は「イオンイメージングモード」で行った。 これは、一次イオンビームを試料表面で走査し、各 点からの二次イオン信号強度を記録することで、測 定対象とするイオンの二次元分布を得る手法である。 各二次イオンのイメージは100枚から300枚程度(1 枚あたりの分析時間は約50秒)取得し、注入イオン の深さ方向プロファイルを得た。この分析モードで は、得られたイメージにおける任意の領域からの二 次イオン信号のみを抽出できる。今回は、試料表面 の汚染の影響を最小限にするため、また、精度のよ い深さ方向プロファイルを作成するため、イメージ の中心領域からの二次イオン信号のみを抽出した。

最後に、注入イオンと試料由来のイオンの SIMS 感度を評価した。前者については、深さ方向プロファイルの信号強度の積算し、既知のドーズ量と分析深さから得られた注入イオンの濃度で割って感度を計算する。後者については、試料中の C あるいは Cr の 濃度は既知であるため、信号強度の積算値をその濃度で割って感度が計算できる。

3. 結果と考察

3.1 注入 ⁵³Cr と試料由来の ⁵³Cr の感度比

カンラン石および NIST 612 glass 中の Cr の感度は ほぼ等しい (~300 cps/wt%/pA)。一方、注入した⁵³Cr の感度は試料由来の⁵³Cr の感度と最大 50%程度異な る (Table 1)。しかし、カンラン石および NIST 612 glass の間でこの感度差(=注入イオン/試料由来イオ ン)はほぼ等しい。このことは、実際に感度が異な るのではなく、ドーズ量の不確定性によって、見か け上、感度に差があるように観測されていることを 示唆している。このドーズ量の不確定性は、今回の 実験で行ったように、二つの試料を全く同じ条件で イオン注入することによってキャンセルすることが できる。

TT 11 1 T		C 1 .	1 1		520
Table I Ion	vielde o	st implant	ed and	intrincio	JJ 'r
	vicius u	n minnam	cu anu	mumsic	
	2				

ruble 1. fon yleids of implanted and member						
分析	注入 ⁵³ Cr	試料由来 53Cr	注入/試料			
	カウント	カウント	比			
	(cps/wt%/pA)	(cps/wt%/pA)				
カンラン石						
#1	636	457	1.39			
#2	385	250	1.54			
NIST 612 glass						
#1	438	304	1.44			
#2	404	310	1.30			
#3	363	285	1.27			

3.2 注入¹³Cと試料由来の¹³Cの感度比

方解石中の C の感度 (~150 cps/wt%/pA) は、SiC の感度 (~3,000 cps/wt%/pA) よりもはるかに低い。ま

[2023201001]

た、方解石中の C の感度は O の感度(約 5,000 cps/wt%/pA) よりもはるかに低い。炭酸塩中 C の感 度が極端に低いことは、以前の研究でも報告されて いる^[3]。

しかし、SiC と方解石の両方について、注入した ¹³C の感度は試料由来の¹³C の感度と最大 20%程度 しか変わらなかった(Table 2)。つまり、Cの感度 の絶対値は SiC と方解石で一桁以上異なるものの、 感度差(=注入イオン/試料由来イオン)はほぼ等し い。このことから、上の 53Cr の結果と合わせて、注 入イオンと試料由来のイオンは SIMS の二次イオン 生成効率という観点では同じように振る舞うと考え られる。すなわち、SIMS の二次イオン生成効率は、 原子が結晶構造中に存在しているか否か、あるいは 化学結合を構成しているか否か、にはあまり依存せ ず、元素のイオン化エネルギーや原子が存在する物 質の性質(マトリクス)のみに依存する、というこ とになる。したがって、今回の実験から、SIMS の標 準試料作製のためにはイオン注入は有効な手段であ ると結論づけることができる。

分析	f 注入 ¹³ C	試料由来 ¹³ C	注入/試料				
	カウント	カウント	比				
	(cps/wt%/pA)	(cps/wt%/pA)					
SiC							
#1	3760	3139	1.20				
#2	3665	3121	1.17				
#3	4229	3493	1.21				
方解石							
#1	177	153	1.16				
#2	162	145	1.12				
#3	160	147	1.17				
#4	146	132	1.11				

Table 2: Ion yields of implanted and intrinsic ¹³C

参考文献

- [1] R. C. J. Steele, et al., "Matrix effects on the relative sensitivity factors for manganese and chromium during ion microprobe analysis of carbonate: Implications for early Solar System chronology", Geochimica et Cosmochimica Acta 201, 245– 259 (2017).
- [2] http://www.srim.org/
- [3] M. G. Śliwiński, et al., "Secondary ion mass spectrometry bias on isotope ratios in dolomite–ankerite, part I: δ¹⁸O matrix effects", Geostandards and Geoanalytical Research 40, 157–172 (2016).
- [4] M. G. Śliwiński, et al., "Secondary ion mass spectrometry bias on isotope ratios in dolomite–ankerite, part II: δ^{13} C matrix effects", Geostandards and Geoanalytical Research 40, 173–184 (2016).